-76

	## 11 77 2010-11 00 0 00
	- 、判断立误(10分) 1、逻辑代数是数字电子技术的数学理论基础。它能够对数字电路特性进行完备地描述。 (X)
	2. CMOS 反相器的电压传输特性曲线描述了输入/输出电压之间的关系,但无法反映它的传输延迟时间的长短。 3. 当 CMOS 反相器输出逻辑高电平时、PMOS 管工作在可变电阻区、NMOS 管工作在
1	* 截止区, 4. 在TTL (7 电路实现的数字系统中,逻辑高/低电平代表逻辑 1/0, 对应的物理电平值就 是 5 V 和 0 V
	5. CMOS 门电路在正常使用时不能悬空、其输入闲置端可以统一采用接地方式来处理。 6. CMOS 门电路的主要功耗是动态功耗,可以通过提高电路工作频率来降低。()
	7. 有 3 个 CMOS 三态门,它们的输出端 F, F,和 F,连接在同一条总线上,但它们的使能 检制端 EN,, EN,和 EN,不能连在一起用同一个信号来控制。 8. 所有的竞争冒险现象在组合电路中属于偶然发生,在电路正常工作时不会反复出现。
	9. 与TTL 门电路相比, CMOS 门电路的扇出系数较高的原因是, CMOS 门电路的驱动
	能力强于 TTL 门电路。 10. 书 168 給出普通編碼器的真值表见表 4.3.1,表中未出现的取值组合是函数的任意项。 (×)
= -	2. 74 July 2. 10 40 44 () () ()
2.	142
3.	는 전 등 100 kg 등 시간 보내 사용성 가게 되는 것 같아요. [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
4.	(3分)将任意的 7 变量逻辑函数 F(A,B,C,D,E,F,G)化为最简与或形式,最多可能含有 (4)个相或的与项。
5.	$(4 \mathcal{G}) Y = (A \oplus B)(C \oplus D)'$ 的最小项之和的形式是: (请填入最小项和最大项的编号、证: $m_{10} = AB'CD'$), $Y = \sum m(A, 7, 8, 1)$
6)	最大模之积的形式是: $Y = \prod M(0.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$ 。 $(4 + 6)$ 对 $Y = AB + AC' + BC' + B'C + B'D + BD' + ADEF$ 进行化简,将最简与或式: $Y = (A + BC' + BC + BD + BD')$ $Y = (A + BC' + BC' + BC' + BD')$
7	Y = A'C'D + ABC'D + ABCD'
	Y=(N/ Par Day 1 1

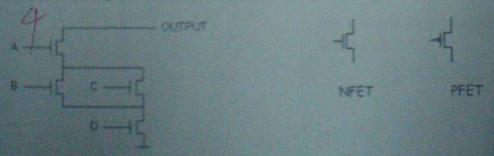
8. (2分) 用 16选 1 的数据选择器, 至多可以实现含有(合理线函数。

) 个支量的任意组

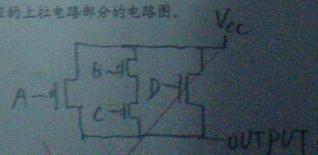
	ALCE DEED THE RELEASE		
The state of the s		200	9/4/13
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	学号	姓名_九	2
			10
	- E-C EM	◎题动 16 个 2 输入 ³	5年门。
9. (8分) 左侧中的 TTL 标准系列继承的包	A STONE	HINGHAL AV	A A SE
9。 (8分) 左衛中由 TTL 标准系列建筑的 著格 GM 后级的与非门提底相同系列约 4	能入武非15. 烈也	M RESERVED A	4 2 42
CMOS A#TI. PLG	mm = 1 / 1	个4输入或非门。	EG uk
* HD- CMOS 4#11- #14	M SENERAL PARTY	SEEMS CMOSH	74AHC
" IO CMOS A # III 形 IV 用的是 TTL 的 14 标准	1条列,后见的11 BA	A KAN STA CHIOS	
10- 系列、电路(包	至 主家工作。	-1	
10、 (7分)根据下图直接写出逻辑函数式 Y	= 1 ARFAB(+1	ABC.).
10、 (7分)根据下图直接与五三十二五八月	*/ and #	C'+A'B'C'): 若
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	A THE RESERVE OF THE PARTY OF T	and the
一 日本 医中的	与个门的时间参数为	$t_{pd} = 5ns, t_{cd} = 1$	23 1112
		Tod = (Ansy)	
	TOUS	a Tinx	
		1 it it .	
11. (7分)根据左图写出逻辑函数表达式。	责化两政和两司以	1 1 - 1	
V.=(100 A)	(4) +BC/D+A/	17+5(D	1 Bus toleto
A. R. 的选取不能太小,是	5大小会造成(6	教申沈发烈道	的特里力中VIII
1-F2 F2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	++ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	UNE BOLD HINT	10分级值
1. ① · ① · · · · · · · · · · · · · · · ·	74	いかをイズに	DOTAL T
C-V2			
\$-ID-			
	A		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V _{ad} = SV 5	R=(15K	
12、 (5 分) 知右图、若参数设计合	1 4	/	
现,可以由 NFET 参和 R 共同的	3 3	R = (*)	of the
成反相器,其电压传输特性如图	- Vour		/R=156 E
所示。其中的三条函线分别对应 Vm−	4[2		/ TV
本同的 R 债 (5K, 8K, 15K).	→ 1		1/200
在图中标明曲线与阻值的对应关	inverter 0		> Va
A:		1 2 3 4	
在 R=15K 射, 该同取			
V ₁₀ = 0.5V ₁ V ₁₀ = 1.0V ₁ V ₁₀ = 4V ₁ V ₁₀	_=3V (2/ 3	5)合理?输入	宋声客张

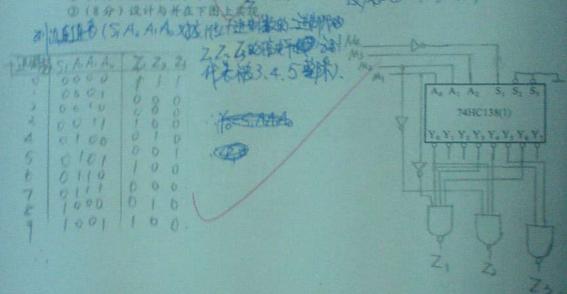
N=(05)V. 三、设计(32分)

1 (8分) 下图是一个 CMOS 门电路的台 NFET 构成下柱电路部分;



(I) (14分) 虽出该CMOS门电路中相应的上往电路部分的电路图。





3. (14分) 现有一个简易计算器,如下图、该计算器可以根据输入 A. 实现对输入的 3 位元 符号二进制数 D(D₂D₁D₀)的不同处理、分别得到 V=2D.

Y=30 1 Y=02.

① (1分) 輸入交量 A 庄至少取 [...

②(1分)输出变量》应至少应取(

Hab Vandara a ra k

#△ D(D ₂ D ₁ D ₀)	柳井 外 年 年 7 年
000	800000
201	000001
0 10	00000
100	001001
101	010000
110	100100
CLY	10001

计算器

① (4分)请根据②的真值表。写出输出的 最简与或表达式:

y= D, D, + D, D, D, \
\(\frac{1}{3} = D, D, \frac{1}{3} + D, D, \frac{1}{3} + D, \frac{1}

	学 《数字电子技术基础			2009/4/13	BE
③ (63 构建该	分)现有中规模器件数据运 "簡易计算器",试着画台	出电路头现示思国,	PURT SELL LONGING	中规模器件的前提下, 在其中完成的功能,	F
	14HC128	1 3 1886, 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	54 60 TQ - 51 1 - 51	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	A SOM	选择 <u>一位</u> 型	中的组	新文的A 11~915,921~925,921 第一个第一个专项XX 出其中的一种)	*
			カト1 A-	10时 椭似 9,~9.	·#. 20